

202e 940nm VCSEL

产品规格书 Product Specification Data

产品名称: QM_202e_940nm_VCSEL

Product Name

物料编码: SV122421

Part Number

受控编号: TS01081

Record Number

版本: A1

Version

受控日期: 2025.02.25

Date

公司地址:徐州高新技术产业开发区集成电路产业园二期3号厂房公司网址:http://www.qianmulaser.com.cn



电光特性 Electro-Optical Characteristics

除特殊说明以外,所有的参数均为50°C (基板温度),QCW模式下测试所得 (I_{op} =1.3A, τ_{p} =0.3ms, DC=10%)。 Unless otherwise specified, all parameters are 50° C (substrate temperature), measured in QCW mode ($I_{op}=1.3$ A, $\tau_p = 0.3 \text{ms}, DC = 10\%$).

参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	备注 Comments
工作温度 Operating Temperature	$T_{ m op}$	0	50	70	°C	-
脉宽 Pulse Width	$ au_{ m p}$	-	0.3	-	ms	-
工作周期 Duty Cycle	DC	-	10	-	%	-
工作电流 Operating Current	$I_{ m op}$	-	1.3	-	A	-
阈值电流 Threshold Current	$I_{ m th}$	-	160	230	mA	-
工作电压 Operation Voltage	$V_{ m op}$	-	2.0	2.3	V	-
工作电压 Operation Voltage	$V_{ m op1}$	1.7	-	1.9	V	按电流分 (Bin1) Divided by current (Bin1)
工作电压 Operation Voltage	$V_{ m op2}$	1.9	-	2.1	V	接电流分 (Bin2) Divided by current (Bin2)
工作电压 Operation Voltage	$V_{ m op3}$	2.1	-	2.3	V	接电流分 (Bin3) Divided by current (Bin3)
输出功率 Output Power	$P_{ m op}$	1.0	1.2	-	W	-
能量转换效率 Power Conversion Efficiency	PCE	38	45	-	%	-
斜效率 Slope Efficiency	η	0.90	1.0	-	W/A	-
微分电阻 Differential Resistance	$R_{ m d}$	-	0.45	0.70	Ω	-
一致性 Uniformity	UNI	-	-	15	%	
光束发散角 Beam Divergence (1/e²)	Θ	-	20	25	deg.	-
中心波长 Center Wavelength	λ	930	940	950	nm	-
波长温变系数 Wavelength Shift Coefficient	Δλ/ΔΤ	-	0.07	-	nm/°C	0°C-70°C
均方根谱宽 Spectral Width (rms)	$\Delta \lambda_{ m rms}$	-	-	4	nm	-

公司地址:徐州高新技术产业开发区集成电路产业园二期3号厂房

公司网址: http://www.qianmulaser.com.cn



额定参数 Absolute Maximum Ratings

参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
反向电压 Reverse Voltage	$V_{ m r}$	-	5	V
存储温度 Storage Temperature	$T_{ m s}$	-40	100	°C
存储湿度 Storage Humidity	H_{s}	-	95	%
贴片温度 Die Attach Temperature	-	-	260	°C

芯片尺寸 Chip Dimensions

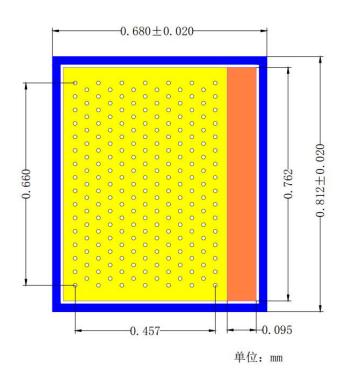
参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
发光孔数 Total Emitter Number	$N_{ m e}$	-	202	-	-
芯片尺寸(高度) Die Size (Height)	Н	792	812	832	um
芯片尺寸(宽度) Die Size (Width)	W	660	680	700	um
芯片厚度 Chip Thickness	D	90	100	110	um
发光区高度 Emission Area Height	Н	-	660	-	um
发光区宽度 Emission Area Width	W	-	457	-	um

公司地址:徐州高新技术产业开发区集成电路产业园二期3号厂房

公司网址: http://www.qianmulaser.com.cn



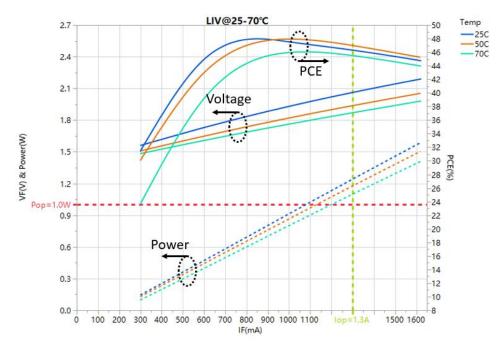
机械图纸 Mechanical Drawing



电光转换曲线 Electrooptic conversion curve

此图片所标注的电学与光学特性均在25-70°C条件下,QCW模式下 (0.3ms $10\%~I_{op}=1.3$ A) 测试所得。

The electrical and optical properties indicated in this image were tested at 25-70°C in QCW mode (0.3ms 10% I_{op} =1.3A).



公司地址:徐州高新技术产业开发区集成电路产业园二期3号厂房

公司网址: http://www.qianmulaser.com.cn